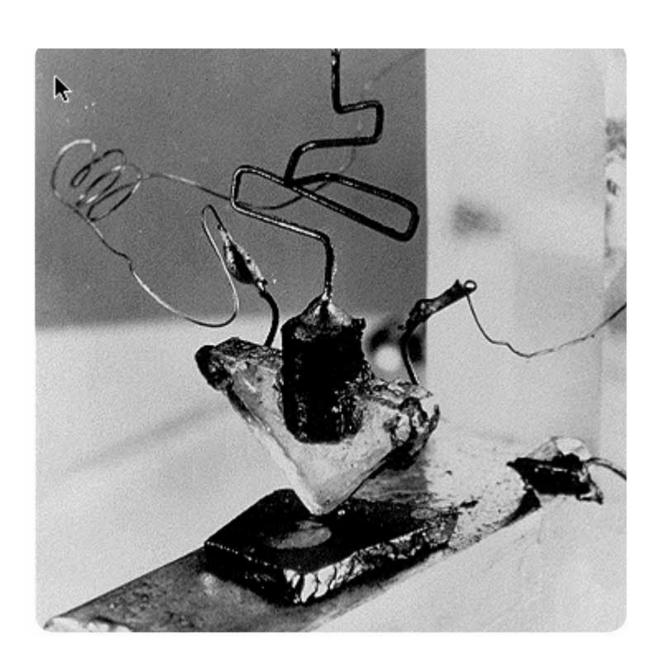
بخش اول سوالات درس الكترونيك عمومي

(BJT مترانزیستور - ترانزیستور



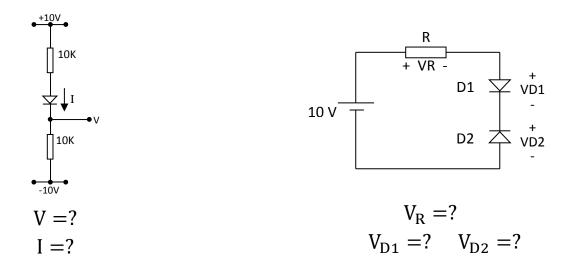
۱- به سوالات زیر بطور خلاصه پاسخ دهید:

الف) با افزایش ناخالصی نوع N به نیمه هادی ذاتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

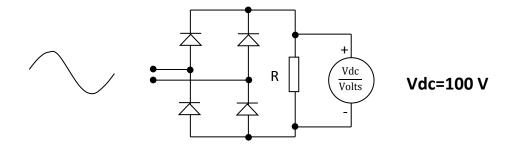
ب) جریان اشباع معکوس دیود به چه عواملی بستگی دارد؟

ج) LED چیست و تفاوت آن با دیود معمولی در چه میباشد؟

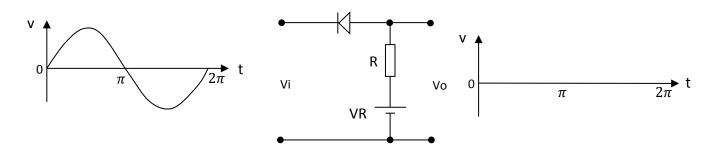
۲- در شکلهای زیر موارد خواسته شده را محاسبه کنید: (دیودها ایدهآل هستند)



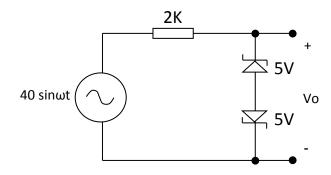
۳- در مدار شکل زیر دو سر هر دیود حداکثر چند ولت ولتاژ قرار می گیرد؟



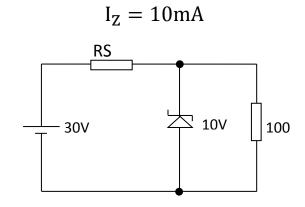
۴- در شکل زیر ولتاژ خروجی را دقیقاً رسم کنید.



 Δ در شکل زیر ولتاژ خروجی چند ولت است؟ دیودهای زنر را ایدهآل فرض کنید.

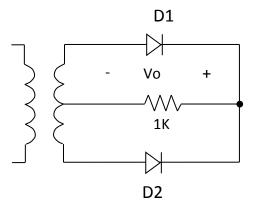


جور مدار زیر RS را بدست آورید.

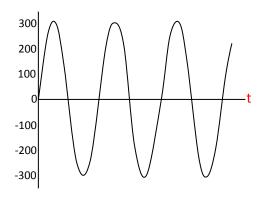


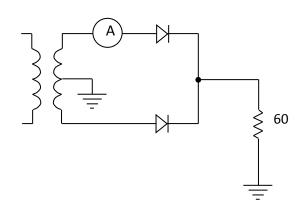
۷- در شکل زیر D1 سوخته است و قطع شده است اگر شکل موج ولتاژ ورودی سینوسی

متناوب باشد شکل ولتاژ خروجی را رسم کنید.

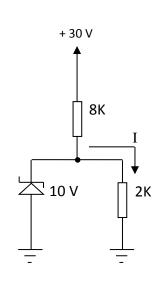


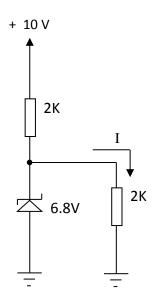
 $(\pi=3)$ جریان چند آمپر را نشان می دهد؟ (DC جریان چند آمپر ا



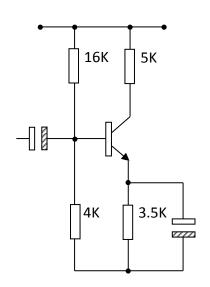


۹- در مدارهای شکل زیر جریان I چند میلی آمپر است؟





است؟ در مدار شکل زیر I_C چقدر است?



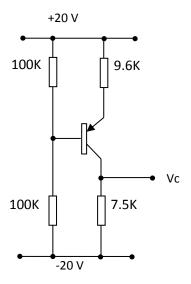
 $h_{\text{fe}}=200\,$

 $V_{BE} = 0.6 V$

Vcc=12V

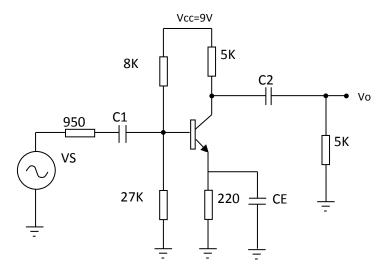
است، اگر بخواهیم از این ترانزیستور $\alpha=0.98$ جریان $\alpha=0.98$ جریان میکرو آمپر جریان باید به بیس اعمال کنیم.

ا در شکل زیر V_{C} چند ولت است $^{\circ}$



 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$

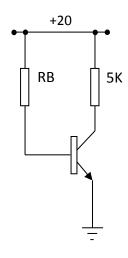
است؟ تقریباً چقدر است $\frac{Vo}{Vs}$ تقریباً چ



 $h_{ie} = 1 K\Omega$

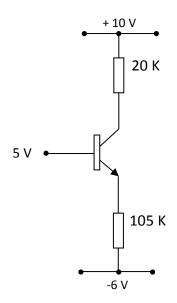
ا ترانزیستور به اشباع می ود؟ I_B ا ترانزیستور به اشباع می ود؟

 $V_{CE(SAT)} = 0$

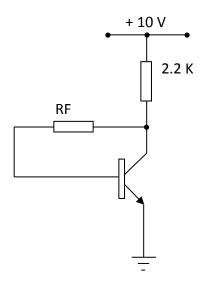


است؟ VCE چقدر است

 $V_{BE} = 0.5 \text{ V}$

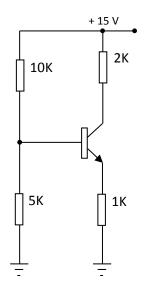


اشد. RF چقدر باشد تا جریان کلکتور RF باشد.



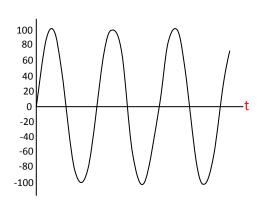
 $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$

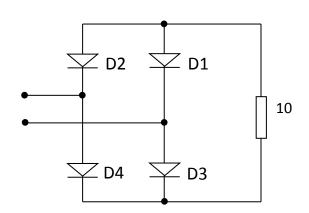
۱۷- توان تلف شده در ترانزیستور چقدر است؟



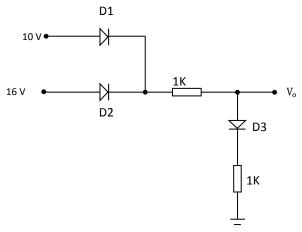
 $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$

مدار شکل زیر جریان DC خروجی را حساب کنید.

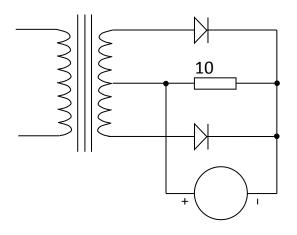




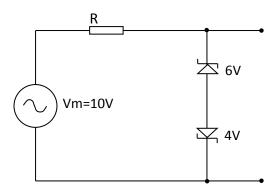
است. در شکل زیر ولتاژ V_{o} چقدر است.



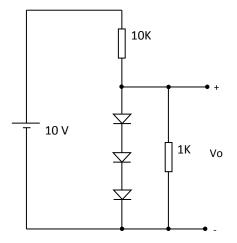
۲۰- در شکل زیر اگر ولتمتر DC مقدار V مقدار DC را نشان دهد جریان هر دیود چند آمپر می شود.



۲۱- مشخصه انتقالی مدار زیر را رسم کنید.

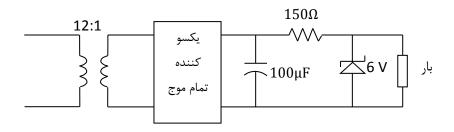


۲۲- در شکل زیر اگر ولتاژ آستانه هدایت دیودها 0.7~V باشد مقدار ولتاژ خروجی را بدست آورید.

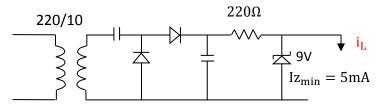


۲۳ در مدار تنظیم کننده زنری زیر حدود جریان بار را بدست آورید.

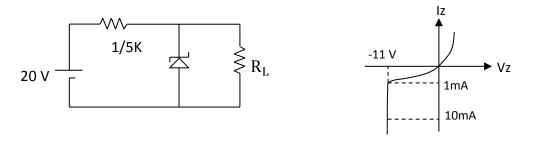
$$V_C \approx V_m - \frac{I_s}{4fc}$$
 $f = 50HZ$, $Iz_{max} = 60mA$, $Iz_{min} = 5mA$



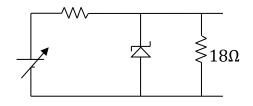
۲۴- در شکل زیر حداکثر جریان بار چقدر است؟



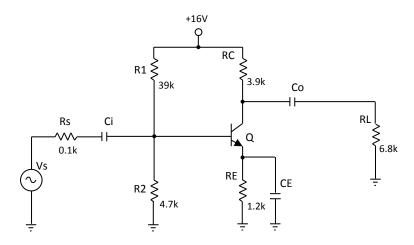
 R_{L} مدار رگولاتور زیر از دیوید زنر با مشخصه زیر استفاده شده است. حداقل مقاومت -70 را بدست آورید.



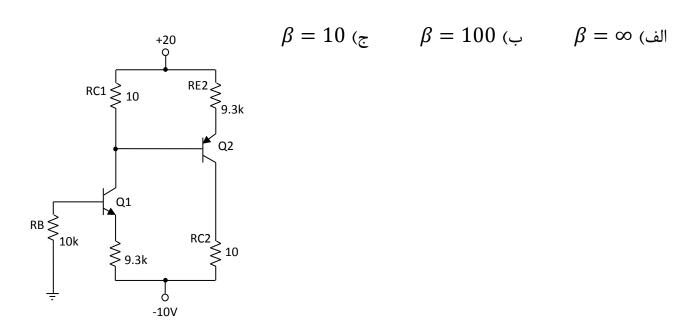
78- در مدار شکل زیر هرگاه جریان عبوری از دیود زنر بین 200 و 24 باقی بماند ولتاژ دو سر دیود 18 است. ولتاژ ورودی از 22 الی 28 تغییر می کند. مقدار مقاومت برای آنکه ولتاژ خروجی در 18 ثابت بماند را بدست آورید.



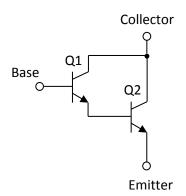
را بیابید. کار DC ترانزیستور را بیابید. β برابر β برابر افرض β برابر عقادیر نقطه کار D



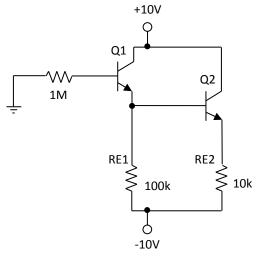
۲۸ - در مدار زیر با فرض اینکه بهره جریان دو ترانزیستور برابرند، به ازای سه مقدار زیر مقادیر نقطه کار را بیابید:



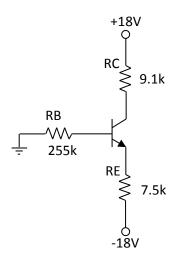
 eta_1 بهم بستن ترانزیستورها به شکل زیر به آرایش دارلینگتون معروف است با فرض eta_1 و -۲۹ بعنوان بهره جریان ترانزیستورها، بهره جریان کل ترانزیستور دارلینگتون را بیابید. eta_2



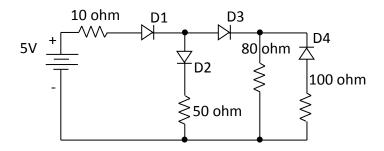
۱۰۰ مقادیر نقطه کار ترانزیستورها را بیابید. eta برابر ۱۰۰ مقادیر نقطه کار ترانزیستورها را بیابید.



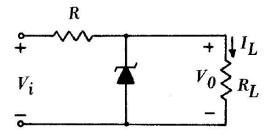
۳۱ مقادیر نقطه کار مدار زیر را با فرض eta مساوی ۱۳۰ بیابید.



۳۲ در مدار زیر (الف) با فرض دیودهای ایده آل و (ب) بار دیگر با فرض افت ولتاژ ۰/۷ ولت روی هر دیود، جریان دیودها را بدست آورید.

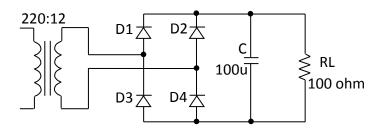


۳۳- الف) در مدار تنظیم کننده زیر اگر مقاومت بار بین ۱ کیلو تا ۱۰ کیلو اهم تغییر کند و بخواهیم خروجی روی P_{Zmax} ، I_{ZK} ، V_{Z}) بخواهیم خروجی روی P_{Zmax} ، I_{ZK} ، V_{Z} بخواهیم ولتاژ خروجی مدار بر روی P_{ZK} ولت ثابت بماند و P_{ZK} برای P_{ZK} ولت ثابت بماند و P_{ZK} برابر ۱ میلی آمپر باشد مشخصات دیود زنر و مقاومت مناسب سری P_{S} را محاسبه کنید.

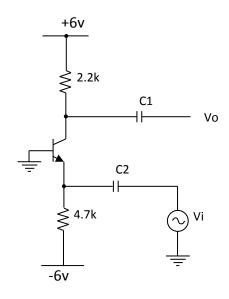


-77 برای مدار شکل زیر، نمودارهای (الف) ولتاژ ورودی، (ب) ولتاژ خروجی، (ج) جریان بار و -77 (د) ولتاژ دو سر -77 را ترسیم نموده و مقادیر دقیق عددی مربوطه را محاسبه کرده و روی نمودار نشان دهید. (ه) مقدار ولتاژ -77 خروجی چقدر است؟ (و) مقدار ولتاژ ریپل خروجی را محاسبه کنید و (ز) مقدار «ریپل فاکتور» را هم بدست آورید.

* محاسبات بخشهای ه تا ز با خازن ۴۷ میکروفاراد و بار ۱۸۰ اهمی تکرار شود و نتایج با مقادیر قبلی مقایسه شود.



۳۵- در مدار شکل زیر اگر ترانزیستور دارای ضریب بهره جریان ۱۰۰ باشد مقاومت ورودی و مقاومت خروجی و بهره ولتاژ تقویت کننده را بدست آورید. (۴ نمره)



۳۶- ولتاژ خروجی یک مدار یکسوساز نیم موج ۸ وات است و ولتاژ مؤثر ورودی مدار ۶ ولت میباشد ولتاژ ریپل بار برحسب ولت چقدر است؟

$$V_m = V_e \times \sqrt{2} = 6 \times \sqrt{2} = 8/4v$$

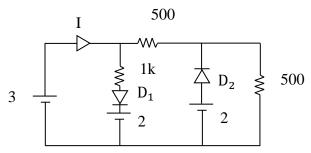
$$V_{dc} = V_m - \frac{V_r}{2} \implies 8 = 8/4 - \frac{V_r}{2} \qquad V_r = 0/8v$$

۳۷- ولتاژ خروجی یک مدار یکسوساز تمام موج ۱۵ ولت است که یک بار یک کیلو اهمی را تغذیه می کند حداقل ظرفیت خازن فیلتر آن چند میکرو فاراد باشد تا ولتاژ ریپل از ۱۳/۰ ولت بیشتر نشود؟

$$V_{r} = \frac{I_{dc}}{2fC} \qquad 0/3 = \frac{I_{dc}}{2 \times 50 \times C} = \frac{15 \times 10^{-3}}{2 \times 50 \times C} \qquad f = 50 hz$$

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R_{r}} = \frac{15}{1k} = 15 mA \qquad C = 0/5 \times 10^{-3} F = 500 \mu F$$

۳۸ در شکل زیر جریان I چقدر است؟



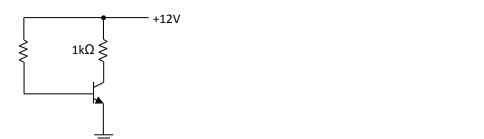
حتماً روشن است D_1

اگر
$$D_2$$
 خاموش باشد $V_{500\Omega}=rac{1}{2} imes3=1/5v$

 $m V_{500\Omega} = 2v \leftarrow$ چون آند $m D_1$ چون آند $m D_2$ به جون آند وصل است تناقض داریم $m D_2$ پس

KCL:
$$-I + \frac{V_i - 2}{1k} + \frac{V_i - 2}{500} = 0$$
 $I = 3mA$

۴۰- در شکل رو به رو، اگر بیس ترانزیستور قطع شود، V_{CE} ترانزیستور چند ولت میشود؟ (قبل از قطع بیس $V_{CE}=6$ بوده است)



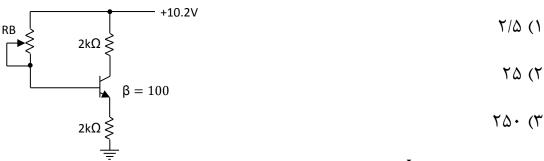
17 (4

· (1

٣ (٢

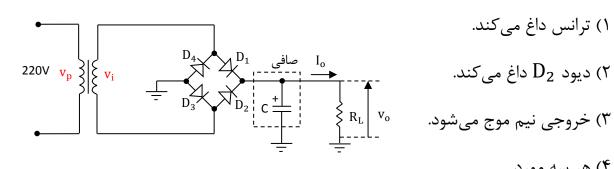
۶ (۳

۴۱- در تقویت کننده رو به رو، مقدار $R_{
m B}$ را طوری تغییر دادهایم که ترانزیستور وارد منطقه اشباع شده است. در این حالت $I_{
m B}$ ، چند میکروآمیر است؟



) نمی توان مقدار I_{B} را تعیین کرد.

۴۲- در مدار شکل روبهرو اگر دیود D_4 اتصال کوتاه شود چه اتفاقی برای مدار رخ میدهد؟



١) ترانس داغ مي كند.

۴) هر سه مورد

۴۳- اتم سیلسیوم دارای چند الکترون ظرفیت است؟

۴۴- اتمهای سیلسیوم در یک وضعیت منظم بنام قرار دارند.

۴۵- یک نیمه هادی ذاتی در درجه حرارت اتاق دارای تعدادی حفره است. چه عاملی این حفرهها را ایجاد کرده است؟

۴۶- ادغام الکترون آزاد و حفره رامی گویند.

۴۷- زمان بین ایجاد یک حفره و از بین رفتن آن را می گویند.

```
۴۹ - وقتی یک ولتاژ به نیمه هادی اعمال شود، حفرهها به چه سمتی حرکت می کنند.
                    ۵۰ در یک نیمه هادی ذاتی تعداد الکترون آزاد و حفرهها ..............
          ۵۱ - با ...... درجه حرارت تعداد الکترونهای آزاد و حفرهها افزایش می یابد.
  ۵۲ حرکت الکترونهای آزاد بسمت چپ به معنی حرکت حفرهها بسمت .............. است.
                                      ۵۳ حفرهها مانند بار .....عمل می کنند.
                   ۵۴- در چه نوع نیمه هادی حفرهها حاملهای اقلیت محسوب میشوند؟
       ۵۵- نقره بهترین هادی است. فکر می کنید در مدار ظرفیت دارای چند الکترون است؟
p اعمال می p اعمال می کنیم. اگر سمت چپ نیمه هادی به p اعمال می کنیم. اگر سمت p نیمه هادی به
 قطب مثبت باطری متصل باشد. حاملهای اکثریت نیمه هادی به چه سمتی حرکت میکنند.
              ۵۷ در یک کریستال هر اتم سیلسیم در مدار ظرفیت خود چند الکترون دارد.
              ۵۸ ولتاژی که در آن پدیده بهمن اتفاق میافتد .......... نامیده میشود.
۵۹ ولتاژ معکوس ۲۰ ولت به یک دیود اعمال شده است. ولتاژ دو سر لایه تخلیه چقدر است؟
۶۰ اجسامی که در یک میدان الکتریکی معمولی جریان الکتریکی را هدایت نمی کنند و فقط
           ممکن است در میدانهای خیلی قوی جریان آنها عبور کند چه نامیده میشوند؟
۶۱- با شکستن هر پیوند و رها شدن هر الکترون، یک جای خالی در پیوند باقی میماند که به
                                                          آن .....می گویند.
```

۴۸- نیمه هادی دارای چند نوع جریان است؟

۶۳- در یک پیوند P-N پیشرفت ناحیهدر طرفی که دارای چگالی ناخالصی کمتری است بیشتر میباشد.

۶۴ در درجه حرارت اطاق نیمه هادی خالص سیلیسیوم تقریباً مانند عمل می کند.

۶۵- به چه اتمی یون مثبت گویند.

8۶- چه عاملی لایه تخلیه را بوجود آورده است.

۶۷ در دمای اطاق پتانسیل سد ژرمانیوم چقدر است؟

۶۸- وقتی ولتاژ معکوس از ۲ ولت به ۱۰ ولت افزایش یابد، لایه تخلیه